# 基于游标效应的温度传感器

谢佳一,王朝宇,赵昆鹏,邢铭珈,张庆洋,李明宇<sup>1</sup> (长春理工大学,长春 130012)

**摘要:**提出了一种基于游标效应的温度传感器。这种温度传感器由法布里-珀罗标准具和微 环谐振腔级联组成,其中法布里-珀罗标准具起到滤波的作用,温度传感元件为微环谐振腔。 分别利用波长探测方法和强度探测方法进行了传感器性能测试。实验结果表明,波长探测灵 敏度为 1.4903nm/℃,探测范围为 11.88℃,探测极限为 0.0417℃;强度探测灵敏度为 1.5256dB/℃,探测范围为 2℃,探测极限为 0.045℃。这种基于游标效应的温度传感器具有 体积小、灵敏度高、探测方式灵活、可实现低成本探测的优势。 关键词:游标效应;法布里-珀罗标准具:微环谐振腔;波长探测;强度探测

## Temperature sensor based on vernier effect

Xie Jiayi, Wang Zhaoyu, Zhao Kunpeng, Xing Mingjia, Zhang Qingyang, Li Mingyu

(Changchun University of Science and Technology Chang chun 130012)

**Abstract:** A temperature sensor based on vernier effect is proposed. This temperature sensor is composed of a cascade connection of a Fabry-Perot etalon and a micro-ring resonator, wherein the Fabry-Perot etalon plays the role of filtering, and the temperature sensing element is a micro-ring resonator. The sensor performance was tested by the wavelength detection method and the intensity detection method, respectively. The experimental results show that the wavelength detection limit is 0.0417°C; the intensity detection sensitivity is 1.5256dB/°C, the detection range is 2°C, and the detection limit is 0.045°C. The temperature sensor based on the vernier effect has the advantages of small size, high sensitivity, flexible detection method, and low-cost detection.

Keywords:Vernier effect; Fabry-Perot etalon; microring resonator; wavelength detection; intensity detection

第一作者信息: (谢佳一,女,硕士研究生,微纳光学与光子器件及应用,344843194@qq.com) 通讯作者信息: (李明宇,男,教授,集成光学,limngyu@cust.edu.cn)

## 1 传感器设计背景和应用价值

设计背景:

基于光波导的传感器因为具有成本低、结构紧凑、集成度高等优点在近些年的研究中取得了一定的进展。由于光波导材料的热光效应,一些基于光波导的温度传感器也被设计出来。 但是微环谐振腔的温度灵敏度受限于构成光波导材料的热光系数,在之前报道的结果中,基 于波长探测的灵敏度数量级只能达到10-2nm/°C[1,2]。波长探测需要价格昂贵的光谱仪或可 调谐激光器,降低探测成本迫在眉睫。

应用价值:

基于游标效应的温度传感器体积小,封装后可与其他仪器集成,并且具有低成本和高灵 敏度的优势,在工业、医学、生物等对温控要求较高等领域均有良好的应用前景。

## 2 创新点与优势

利用法布里-珀罗(FP)标准具和微环谐振腔(MRR)级联产生的游标效应,放大了灵敏 度,降低了探测极限,并具有波长探测和强度探测两种探测方法,实现了低成本易集成的基 于游标效应的温度传感器。可以应用于工业、医学、生物等对温控要求较高等领域中。

## 3 实现方案简介

#### 3.1 设计原理

设 FP 标准具和 MRR 的自由光谱范围分别为 FSRF 和 FSRM,透射谱峰值恰好在波长为 λ0 时重叠, k 为整数, FP 标准具和 MRR 全部峰值位置为:

$$\lambda_{k,F} = \lambda_M + kFSR_F$$

$$\lambda_{k,M} = \lambda_M + kFSR_M$$
(1)

FP 标准具和 MRR 透射谱线峰值出现第一个重合位置λ0 开始,直到 k=K 时 FP 标准具 和 MRR 下一个干涉峰完全重合出现下一级联双环光谱包络峰值位置,则有:

$$\lambda_{F,K} = \lambda_{M,K+1} \tag{2}$$

FP 标准具和 MRR 级联后光谱包络周期为:

$$FSR_{FPMRR} = \lambda_{F,K} - \lambda_M \tag{3}$$

结合以上公式可以推导出 FP 标准具和 MRR 级联后的自由光谱范围为:

$$FSR_{FPMRR} = \frac{FSR_F \times FSR_M}{|FSR_F - FSR_M|}$$
(4)

当温度发生变化时, MRR 透射谱线漂移量为ΔλMRR, FPMRR 透射谱线包络漂移量为 ΔλFPMRR, FP标准具和 MRR 级联的温度传感器(FPMRR)产生的游标效应包络光谱灵敏 度相对于单个 MRR 灵敏度可以提高的倍数是:

$$A = \frac{FSR_F}{\left|FSR_M - FSR_M\right|} = \frac{\Delta\lambda_{FPMRR}}{\Delta\lambda_M} \tag{5}$$

如图 1(a)所示,蓝色实线为 FP 标准具的透射谱线,红色实线为初始温度下 MRR 的 耦合输出(drop)端透射谱线,红色虚线为温度增加 3℃时 MRR 的耦合输出(drop)端透 射谱线;如图 1(b)所示,红色实线为初始温度时 FPMRR 的透射谱线,蓝色虚线为温度 增加 3℃时 FPMRR 的透射谱线,红色实线和蓝色虚线分别为这两条透射谱线的包络。



图 1 FP 标准具、不同温度时 MRR 及 FPMRR 的透射谱线

## 3.2 设计方法

基于游标效应的 FPMRR 温度传感器示意图如图 2 所示,其中 FP 标准具和 MRR 通过 光纤阵列形成稳定连接,MRR 放在半导体制冷器(TEC)上,调节 TEC 的温度来使 MRR 升温。



图 2 基于游标效应的 FPMRR 温度传感器示意图

3.2.1 波长探测方法

在波长探测方法下,输入光源为可调谐激光器(Agilent 81642B),图 2 中输出端 C 连接探 测器(Agilent 81635A),用电脑软件控制 TEC 的温度并待其稳定后,对输出端 C 进行扫谱,记录不同的温度与透射谱线包络峰值位置对应关系即可。

3.2.2 强度探测方法

在强度探测方法下,输入光源由宽带光源和滤波器组成,图2中输出端C连接功率计(KEYSIGHT N7745A),用电脑软件控制 TEC 的温度并待其稳定后,记录功率计的功率值即可。在这里为了尽可能减小非温度变化对C端功率值的影响,在A端会连接一分二光纤,使从A端输出的功率一部分直接进入功率计中,一部分进入B端。记录不同温度时这两端的输出功率比值,就能完成强度探测。

#### 3.3 实验验证过程

3.3.1 波长探测

调节 TEC 温度使其以 1℃为温度梯度升温,在 25℃-30℃时的 FPMRR 温度传感器透射 谱线及对应包络如图 3 所示,对上包络进行了高斯拟合以确保较高的灵敏度拟合优度。





不同温度与对应的光谱峰值波长位置数据点如图 4 所示,这种关系是线性的,并进行了 直线拟合,拟合直线如图 4 中蓝色直线所示,斜率为 1.4903。波长探测灵敏度如公式(6) 所示,因此 FPMRR 温度传感器波长探测灵敏度为 1.4903nm/°C。

$$S = \frac{\Delta \lambda_{envelope}}{\Delta T} \tag{6}$$



图 4 波长探测灵敏度拟合结果

实验所用的 FP 标准具的自由光谱范围为 800pm, MRR 的自由光谱范围为 848pm。根据公式(5), FPMRR 的自由光谱范围为 17.7nm, 因为自由光谱范围等于探测范围与灵敏度之积,所以 FPMRR 波长探测范围为 11.88℃。

探测极限 DL 如公式(7)所示,其中δ为标准差。

$$DL = \frac{3\delta}{S} \tag{7}$$

因此我们对 25℃时的光谱扫描了 5 次,将每次探测时的包络峰值记录与表 1 中,可求 波长探测探测极限为 0.0417℃。

衣I 25°C时 5 次保测元语啤道位直								
实验次数	1	2	3	4	5			
峰值波长位置	1542.03	1542.01	1542.05	1542.02	1542.06			
(nm)	×							

#### 3.2.2 强度探测

组合输入光源的半高全宽为 4.5nm,调节 TEC 温度使其以 0.5℃为温度梯度升温,如图 5 所示,数据点为 20℃-26℃时的 C 端输出功率与 A 端输出功率比值,蓝色实线为对强度探测数据点多项式拟合所得,在温度为 20℃-26℃,拟合曲线的变化趋势近似为直线,如图 5 所示,近似的直线斜率为 1.5256,这部分的温度区间长度就是强度探测范围,FPMRR 强度探测范围为 2℃。强度探测灵敏度定义为式(8),其中 neff 为 MRR 的有效折射率,PC、PA 分别为 C 端和 A 端的输出功率,因此 FPMRR 强度探测灵敏度为 1.5256dB/℃。



我们对 25℃时的 C 端输出功率与 A 端输出功率比值重复测量了 5 次,将每次探测时结果记录与表 2 中,可求强度探测探测极限为 0.045℃。

表 2 25°C时 5 次探测功率比

实验次数	1	2	3	4	5
功率比(dB)	-22.258	-22.301	-22.276	-22.287	-22.243

### 参考文献:

- [1] Wang Yimeng, Shu Haowen, Han Xiuyou.Research on high-precision silicon-based integrated optical temperature sensor[J].China Optics,2021,14(06):1355-1361. (in Chinese)
- [2] Cong Hu, Yunying Shi, & Tian Zhou, Chuanpei Xu, Aijun Zhu. A Small Size On-chip Temperature Sensor Based on a Microring Resonator[J].Silicon 2021.